

SF 023*

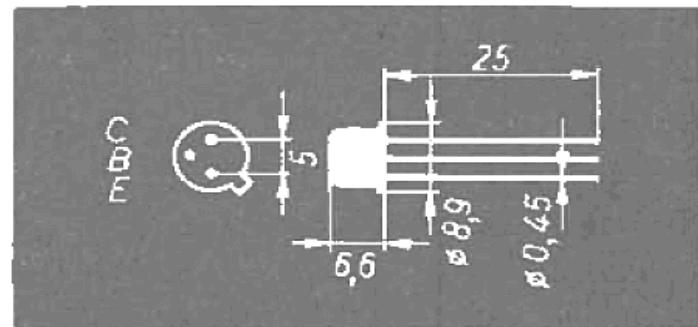
Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker sowie mittelschnelle Schaltstufen

Abmessungen: Bauform B 3/25 - 3a,
TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse
Masse ≈ 1 g

Zulässige Höchstwerte bis ϑ_{Jmax}

U_{CB0}	= 66 V	P_{tot}	= 600 mW
U_{CER}	= 66 V	bei ϑ_a	= 25 °C
bei R_{BE}	= 10 Ω	P_{tot}	= 2,5 W
I_C	= 500 mA	bei ϑ_c	= 25 °C
I_B	= 250 mA	ϑ_j	= +175 °C
ϑ_a min	= -40 °C	ϑ_s	= -40 °C... +150 °C



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 250 \frac{grad}{mW}$
 $R_{thjc} \leq 60 \frac{grad}{W}$

Kennwerte für $\vartheta_a = 25$ °C -5 grad

	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen	Strom- verstärkungs- gruppen
Restströme					
I_{CBO}			100 nA	$U_{CB} = 66$ V	
I_{EBO}			1 μ A	$U_{EB} = 5$ V	
Kollektor-Emitter-Spannung					
U_{CER}		66 V		$I_C = 1$ mA, $R_{BE} = 10$ Ω	
Sättigungsspannung					
U_{CEsat}			1 V	$I_C = 50$ mA, $I_B = 5$ mA	
Übergangsfrequenz					
f_T	60 MHz			$U_{CE} = 10$ V $I_C = 10$ mA, $f = 15$ MHz	
Gleichstromverstärkung					
B	18		35		A
	28		71		B
	56		140		C
	112		280		D
	224		560		E
	450		1120		F

* Nicht für Neuentwicklungen